

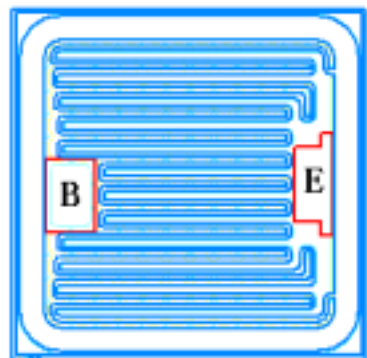


# 13005 晶体管芯片说明书

## 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）  
 芯片代码：D260AG-00  
 芯片厚度：240±20μm  
 管芯尺寸：2600×2600μm<sup>2</sup>  
 焊位尺寸：B 极 366×540μm<sup>2</sup>，E 极 292×560μm<sup>2</sup>  
 电极金属：铝  
 背面金属：银  
 典型封装：KSE13005，HE13005

## 管芯示意图



## 极限值 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-220)

T <sub>stg</sub>	——贮存温度.....	-55~150
T <sub>j</sub>	——结温.....	150
P <sub>C</sub>	——集电极功率耗散 (T <sub>c</sub> =25 ) .....	75W
V <sub>CBO</sub>	——集电极—基极电压.....	700V
V <sub>CEO</sub>	——集电极—发射极电压.....	400V
V <sub>EBO</sub>	——发射极—基极电压.....	9V
I <sub>C</sub>	——集电极电流 (DC) .....	4A
I <sub>C</sub>	——集电极电流 (脉冲) .....	8A
I <sub>B</sub>	——基极电流.....	2A

## 电参数 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-220)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV <sub>CEO(sus)</sub>	集电极—发射极维持电压	400			V	I <sub>C</sub> =10mA, I <sub>B</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			1	mA	V <sub>EB</sub> =9V, I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE</sub>	直流电流增益	10		40		V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =1A
		8		40		V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =2A
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和电压*			0.5	V	I <sub>C</sub> =1A, I <sub>B</sub> =0.2A
				0.6	V	I <sub>C</sub> =2A, I <sub>B</sub> =0.5A
				1	V	I <sub>C</sub> =4A, I <sub>B</sub> =1A
V <sub>BE(sat)</sub>	基极—发射极饱和电压*			1.2	V	I <sub>C</sub> =1A, I <sub>B</sub> =0.2A
				1.6	V	I <sub>C</sub> =2A, I <sub>B</sub> =0.5A
C <sub>ob</sub>	共基极输出电容		65		pF	V <sub>CB</sub> =10V, f=0.1MHz
f <sub>T</sub>	特征频率	4			MHz	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =0.5A
t <sub>ON</sub>	导通时间			0.8	μs	V <sub>CC</sub> =125V, I <sub>C</sub> =2A, I <sub>B1</sub> =-I <sub>B2</sub> =0.4A
t <sub>STG</sub>	载流子贮存时间			4	μs	
t <sub>F</sub>	下降时间			0.9	μs	